**Усов Сергей Олегович. Гетероструктуры для светодиодов видимого диапазона и транзисторов с высокой подвижностью электронов на основе квантоворазмерных слоев InGaN, InAlN и короткопериодных сверхрешеток InGaN/GaN: диссертация ... кандидата Физико-математических наук: 01.04.10 / Усов Сергей Олегович;[Место защиты: Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе Российской академии наук], 2016.- 215 с.**